



中华人民共和国国家标准

GB/T 29506—2013

300 mm 硅单晶抛光片

300 mm polished monocrystalline silicon wafers

2013-05-09 发布

2014-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)提出并归口。

本标准起草单位:有研半导体材料股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准主要起草人:闫志瑞、孙燕、盛方毓、卢立延、张果虎、向磊。

300 mm 硅单晶抛光片

1 范围

本标准规定了直径 300 mm、p 型、〈100〉晶向、电阻率 $0.5 \Omega \cdot \text{cm} \sim 20 \Omega \cdot \text{cm}$ 规格的硅单晶抛光片的术语和定义、技术要求、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于直径 300 mm 直拉单晶磨削片经双面抛光制备的硅单晶抛光片,产品主要用于满足集成电路 IC 用线宽 90 nm 技术需求的衬底片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法
- GB/T 1554 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法
- GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法
- GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法
- GB/T 1558 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 4058 硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法
- GB/T 6616 半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法
- GB/T 6624 硅抛光片表面质量目测检验方法
- GB/T 11073 硅片径向电阻率变化的测量方法
- GB/T 13388 硅片参考面结晶学取向 X 射线测量方法
- GB/T 14140 硅片直径测量方法
- GB/T 14264 半导体材料术语
- GB/T 19921 硅抛光片表面颗粒测试方法
- GB/T 19922 硅片局部平整度非接触式标准测试方法
- GB/T 24578 硅片表面金属沾污的全反射 X 光荧光光谱测试方法
- GB/T 26067 硅片切口尺寸测试方法
- GB/T 29504 300 mm 硅单晶
- GB/T 29507 硅片平整度、厚度及总厚度变化测试 自动非接触扫描法
- GB/T 29508 300 mm 硅单晶切割片和磨削片
- YS/T 26 硅片边缘轮廓检验方法
- YS/T 679 非本征半导体中少数载流子扩散长度的稳态表面光电压测试方法
- SEMI MF 1390 硅片翘曲度的无接触自动扫描测试方法

3 术语和定义

GB/T 14264 界定的术语和定义适用于本文件。